Photo Transistor --ORT-PT1836H2

1. Scope：

- This specification applies to NPN Photo Transistor.

2. Structure：

- Top Side ：alumnium alloy
- Bottom Side ：silver alloy
- Passivation ：Silicon Nitride

3. Size：

- Die Size ：458μm×916μm±30μm
- Thickness ：220μm±20μm
- Pad Size：
- Base ：80μm×80μm±10μm
- Emitter ：Φ120μm±10μm
- Active Area ：300μm×300μm±20μm
- Pattern Drawing：fig.1.

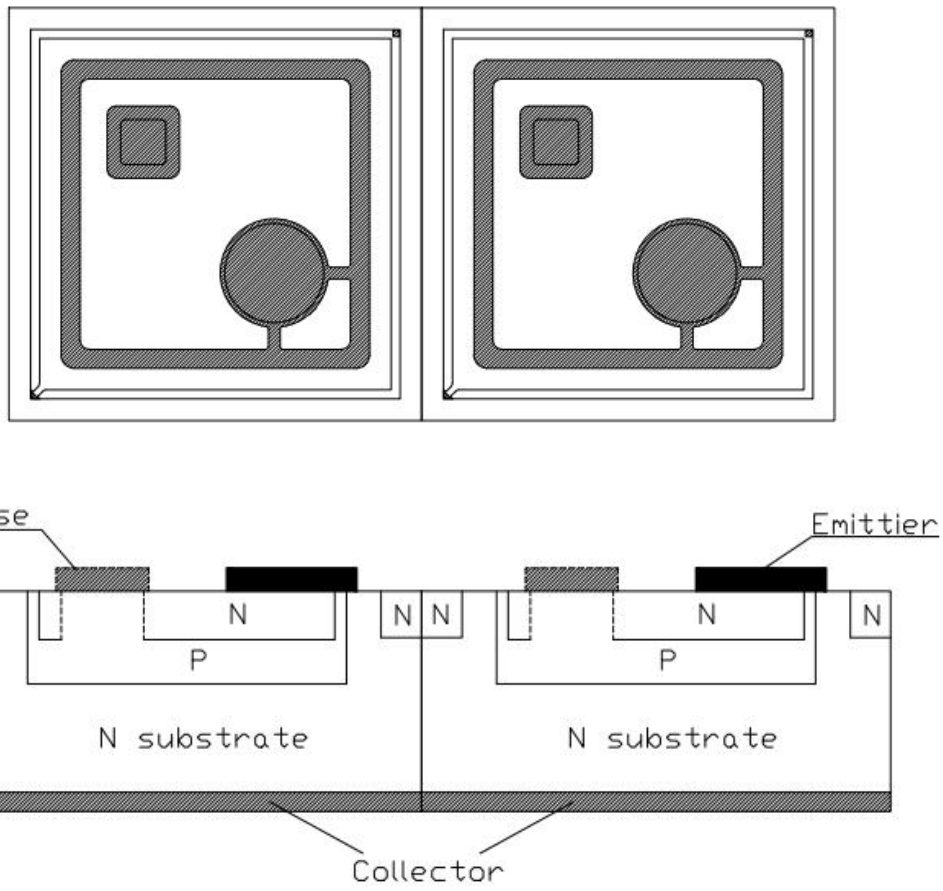


fig.1

4. Absolute Maximum Ratings（极限值）：

（Ta=+25℃）

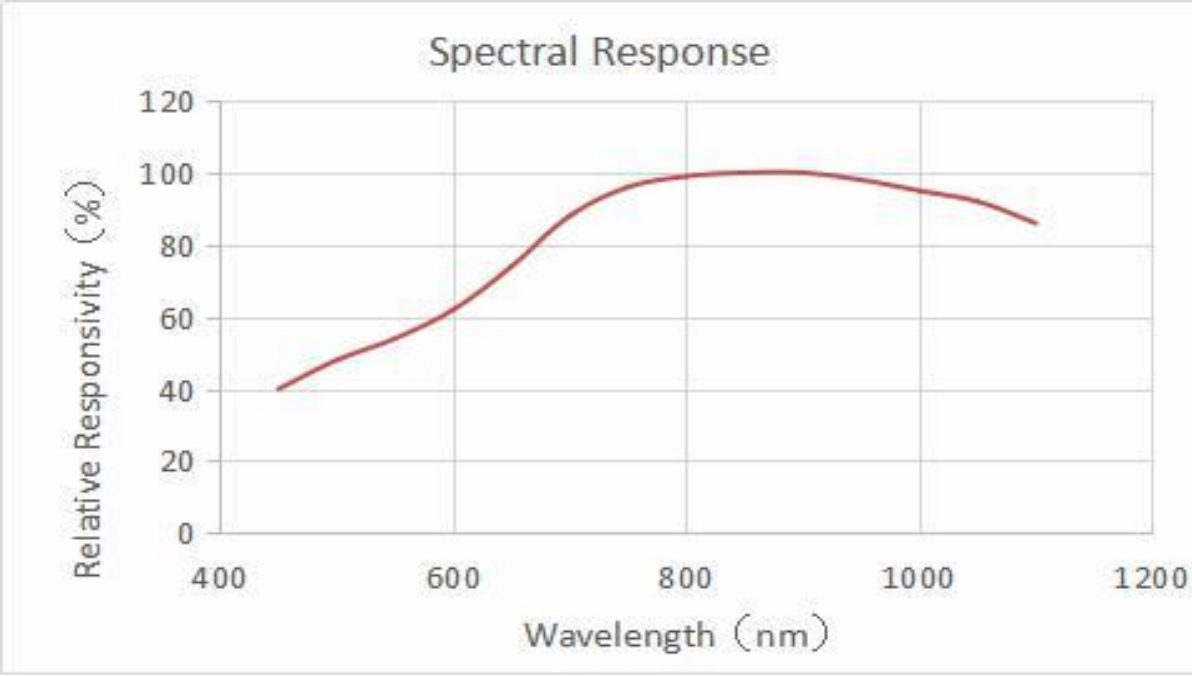
Parameter	Symbol	Maximun rating	Unit
Collecctor-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Collector Voltage	V_{ECO}	6	V
Junction Temperature	T_J	150	℃

5. Electro-Optical Characteristics（光电性能）：

（Ta=+25℃）

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
C-E Leakage Current	I_{CEO}	V_{CE}=20V			50	nA
C-E Saturation Voltage	V_{CES}	I_C=5mA, I_B=1mA			250	mV
C-E Voltage	BV_{CEO}	I_{CE}=500μA	70			V
C-B Voltage	BV_{CBO}	I_{CB}=50μA	70			V
E-B Voltage	BV_{EBO}	I_{EB}=50μA	7			V
E-C Voltage	BV_{ECO}	I_{EC}=50μA	7			V
DC Current Gain	h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=1mA	300			-

6. Spectral Response（灵敏度）



7. Packing ：

- Packing：Sheet Type

8. Application Notes：

- All data are measured by Orient’s tester on bare chips within 98% of the nominal value.